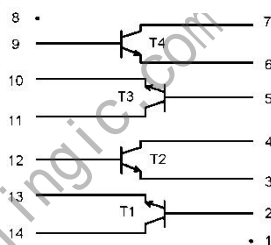


HJ251A/MXT251A NPN 三极管阵列

一、概述

HJ251A/MXT251A 是三极管阵列集成电路，该电路是由四个外延平面型 NPN 三极管组成。它既具有紧密的电匹配和良好的热匹配性能，而且一致性和均匀性比分立管更好。能在-55~+125℃的温度范围内保持良好的性能。

二、电原理图

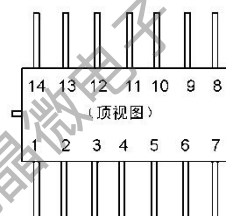


三、封装形式及引出端功能

1. 封装形式

采用 F14-01B 陶瓷扁平外壳封装。

外形尺寸见附录一图 9。



2. 引出端功能

引出端功能如下表

引脚号	1	2	3	4	5	6	7
功能	NC	b ₁	e ₂	c ₂	b ₃	e ₄	c ₄
引脚号	8	9	10	11	12	13	14
功能	NC	b ₄	e ₃	c ₃	b ₂	e ₁	c ₁

四、绝对最大额定值

单管耐压 BV_{CEO}	50V	单管驱动电流 I_{CM}	400mA
工作温度范围	-55~+125℃	耗散功率	600mW
结温	+175℃		

五、电特性

除非另有说明， $T_A=+25℃$ 。

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
共发射极电流放大倍数	h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=10mA$	75	150		
集电极-基极击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=0.01mA, I_E=0mA$	60			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA, I_B=0mA$	30			V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=50V, I_E=0mA$			10	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=60V$			10	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_B=15mA, I_C=150mA$		0.2	1.3	V
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_B=15mA, I_C=150mA$		0.2	0.4	V
特征频率*	f_T	$V_{CE}=20V, I_C=20mA, f=100MHz$	250			MHz
集电结电容*	C_C	$V_{CB}=10V, f=100KHz,$			8	pF

注：*设计保证